

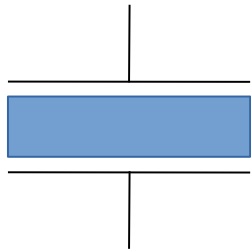
Высокорезистивные материалы

Раджабов Евгений Александрович

Решение задач

Лекция 5

Емкость конденсатора



Емкость конденсатора в вакууме

$C_0 = \epsilon_0 \cdot S/d$; S - площадь пластин, d - расстояние между ними

ϵ_0 – диэлектрическая прониц. вакуума = $8.854 \cdot 10^{-12}$ (а сек)/(в м)

Емкость конденсатора с диэлектриком с

$$C = C_0 \epsilon$$

29.3. Емкость

Если сообщать телу электрический заряд, то его потенциал относительно какой-либо точки (например, Земли) будет возрастать пропорционально заряду: $U \sim Q$. Коэффициент пропорциональности называется электрической емкостью тела. Емкость характеризует способность тела накапливать заряды.

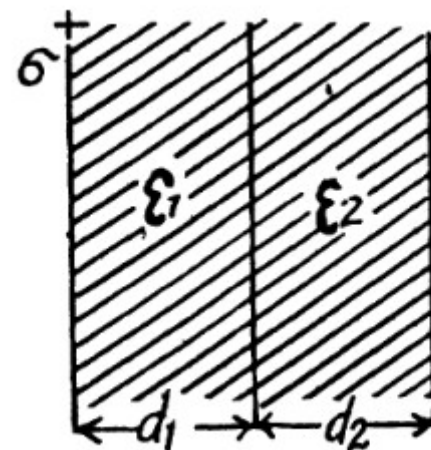
Емкостью C называется отношение сообщенного заряда Q к возникающему в результате этого потенциалу U .



Единица СИ емкости: $[C] = \frac{\text{Кл}}{\text{В}} = \text{фарад (Ф)}$.

Задача 1

3.103. Пространство между обкладками плоского конденсатора заполнено последовательно двумя диэлектрическими слоями 1 и 2 с толщинами d_1 и d_2 и с диэлектрическими проницаемостями ϵ_1 и ϵ_2 . Площадь каждой обкладки равна S . Найти емкость конденсатора



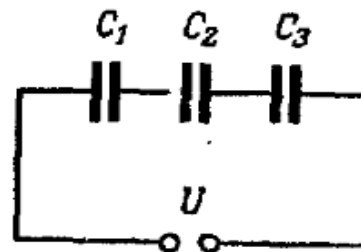
29.3.3. Последовательное соединение конденсаторов

Заряды на последовательно соединенных конденсаторах одинаковы. Полное напряжение равно сумме напряжений на отдельных конденсаторах:

$$U = \frac{Q}{C} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3} + \dots$$

При последовательном соединении конденсаторов величина, обратная величине полной емкости, равна сумме величин, обратных емкостям отдельных конденсаторов:

$$(\text{Э } 29.17) \quad \boxed{\frac{1}{C_{\text{посл}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots}$$

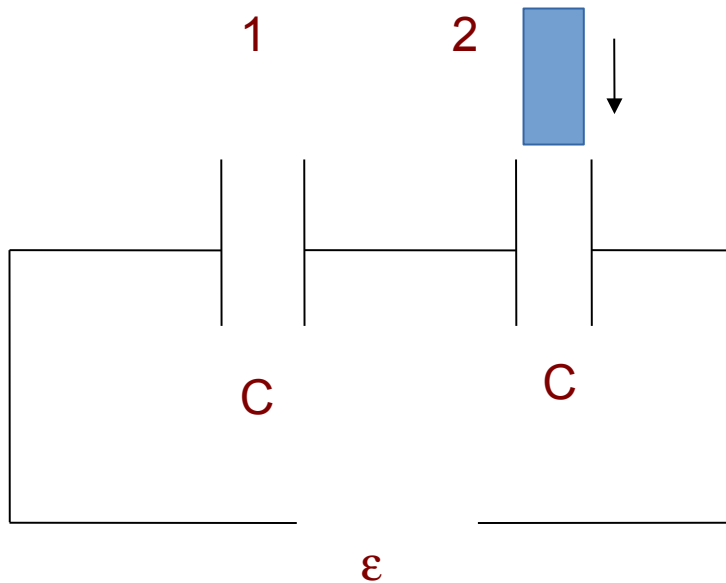


Решение задачи 1

$$\frac{1}{C} = \frac{d_1}{\epsilon_0 \epsilon_1 S} + \frac{d_2}{\epsilon_0 \epsilon_2 S} \quad \text{or,} \quad C = \frac{\epsilon_0 S}{(d_1/\epsilon_1) + (d_2/\epsilon_2)}$$

Задача 2

3.102. К источнику с э. д. с. \mathcal{E} подключили последовательно два плоских воздушных конденсатора, каждый емкости C . Затем один из конденсаторов заполнили однородным диэлектриком с проницаемостью ϵ . Во сколько раз уменьшилась напряженность электрического поля в этом конденсаторе? Какой заряд пройдет через источник?



Решение задачи 2

From the symmetry of the problem, the voltage across each capacitor, $\Delta\varphi = \xi/2$ and charge on each capacitor $q = C \xi/2$ in the absence of dielectric.

Now when the dielectric is filled up in one of the capacitors, the equivalent capacitance of the system,

$$C'_0 = \frac{C\varepsilon}{1 + \varepsilon}$$

and the potential difference across the capacitor, which is filled with dielectric,

$$\Delta\varphi' = \frac{q'}{\varepsilon C} = \frac{C\varepsilon}{(1 + \varepsilon)} \frac{\xi}{C\varepsilon} = \frac{\xi}{(1 + \varepsilon)}$$

But

$$\varphi \propto E$$

So, as φ decreases $\frac{1}{2}(1 + \varepsilon)$ times, the field strength also decreases by the same factor

and flow of charge, $\Delta q = q' - q$

$$= \frac{C\varepsilon}{(1 + \varepsilon)} \xi - \frac{C}{2} \xi = \frac{1}{2} C \xi \frac{(\varepsilon - 1)}{(\varepsilon + 1)}$$

Задача 3

Нарисуйте спектры импеданса (комплексного сопротивления) и адмитанса (проводимости) для

1. $R=1000$ ом

2. $C = 1$ мкФ

3. параллельно соединенные 1000 ом и 1 мкф

спектр импеданса — зависимость Z'' от Z' при изменении частоты от $f_{\text{мин}}$ до $f_{\text{макс}}$

Решение задачи 3

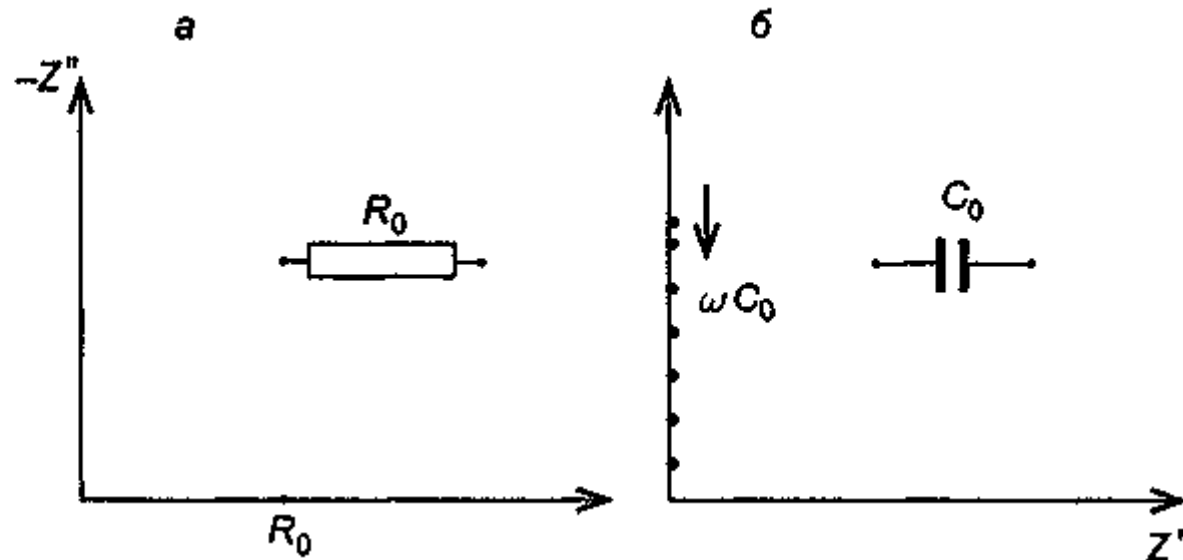


Рис. III.10.3 Годографы импеданса для чисто активного (а) и емкостного (б) сопротивлений.

Нетрудно видеть, что для чисто активного сопротивления R имеем $Z'_R = R$, $Z''_R = 0$ и $Y'_R = 1/R$, $Y''_R = 0$. В плоскости Z' , Z'' сопротивление R представлено точкой на оси Z' при любой частоте ω (рис. III.10.3, а). При замене сопротивления R на емкость C получим, что $Z^* = 1/j\omega C$, поэтому $Z'_C = 0$, $Z''_C = -j/\omega C$; $Y'_C = 0$, $Y''_C = j\omega C$. Как видно, емкость имеет чисто реактивный импеданс (адмиттанс), и Z^* зависит от частоты. На комплексной плоскости Z' , Z'' зависимость $Z^*(\omega)$ для емкости изображается прямой, совпадающей с осью Z'' (рис. III.10.3, б). Графическая зависимость $Z^*(\omega)$ в координатах Z' , Z'' (координаты Найквиста (Nyquist plots)) называется годографом импеданса, или его спектром. Построение годогра-

Решение задачи 3

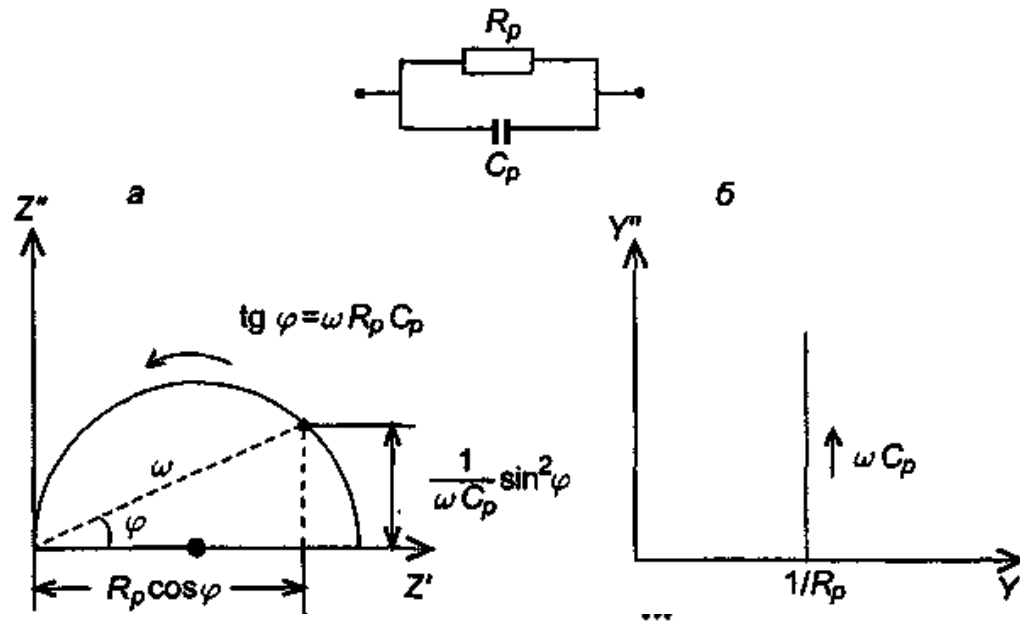


Схема II (рис. III.10.5). Для параллельно соединенных сопротивления R_p и емкости C_p адмиттанс записывается в виде

$$Y_p^* = 1/R_p + j\omega C_p, \text{ или } Y_p' = 1/R_p, Y_p'' = j\omega C_p \quad (4a)$$

Для этого случая годограф адмиттанса представляет прямую линию (рис. III 10 5, б) Импеданс этой схемы рассчитывается аналогично адмиттансу схемы I:

$$Z_p^* = 1/Y_p^* = R_p/(1 + j\omega R_p C_p) = R_p/[1 + \omega^2 R_p^2 C_p^2] - j\omega R_p^2 C_p/[1 + \omega^2 R_p^2 C_p^2]. \quad (4б)$$

Нетрудно показать, что выражение $(Z_p' - R_p/2)^2 + (Z_p'')^2$ является величиной постоянной, равной $(R_p/2)^2$, т.е

$$(Z_p' - R_p/2)^2 + (Z_p'')^2 = (R_p/2)^2. \quad (4в)$$

Уравнение (4в) представляет уравнение окружности с центром в точке с координатами $(R_p/2, 0)$ и радиусом $R_p/2$.